

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年5月25日(2006.5.25)

【公開番号】特開2004-128446(P2004-128446A)

【公開日】平成16年4月22日(2004.4.22)

【年通号数】公開・登録公報2004-016

【出願番号】特願2003-86898(P2003-86898)

【国際特許分類】

H 01 L 27/108 (2006.01)

H 01 L 21/8242 (2006.01)

G 11 C 16/04 (2006.01)

【F I】

H 01 L 27/10 3 2 1

G 11 C 17/00 6 2 1 Z

【手続補正書】

【提出日】平成18年3月24日(2006.3.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0016】

前記第2の導電ゲートと前記第3の半導体領域との電位関係の第1の組み合わせにより、前記第3の半導体領域から前記第2のチャネル形成半導体薄膜部分を通して第1のチャネル形成半導体薄膜部分へ逆導電形のキャリア $A_2$ を注入して、前記第1のチャネル形成半導体薄膜部分の前記第1の導電ゲートから見た第1の導電形のチャネルのゲート閾値電圧を第1の値 $V_{th11}$ に変化させる。本発明ではこの動作を「書き込み」と呼ぶ。